www.sptcorp.com

Si DRIE

異方性・均一性に優れたシリコン深彫りエッチングのための
高精度Si DRIE装置

Cetus, Capella

SPTのSi DRIEシステム (Predeus、Proxion) は、深掘り構造に求められるアスペクト比・エッチング精度・再現性を高い水準で実現します。プロファイル制御や膜厚均一性に優れ、幅広い応用領域において信頼性の高いシリコンエッチングを支えます。

Applications:

- MEMS デバイス
- インクジェットヘッド
- 光学デバイス
- パワーデバイス
- TSV

FEATURES

SPTのSi DRIEが選ばれる理由

優れたエッチングレートと選択性

高い垂直性、低サイドウォール粗さ、CDロスの最小化を維持しながら、業界トップクラスのエッチング速度と選択性を実現。

多様なプロファイルに対応可能な豊富なプロセスライブラリ

豊富なレシピ群により、深掘りエッチング形状の幅広いニーズに対応。迅速なレシピ開発と安定した結果を可能にします。

多様な先端デバイス構造に対応

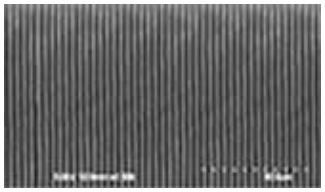
パワーMOSFET、200mm／300mmウェーハ上のTSV形成、その他高アスペクト比構造を要するデバイスに対応可能。

研究開発から量産まで対応可能な柔軟なシステム構成

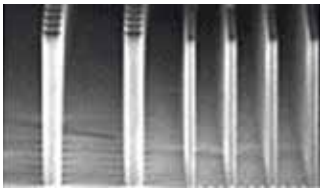
真空ロードロック型からクラスター型まで、導入規模に応じた柔軟なプラットフォームをご用意しています。

PERFORMANCE

高アスペクト比、高速加工、TSV形成に応えるSi DRIE性能

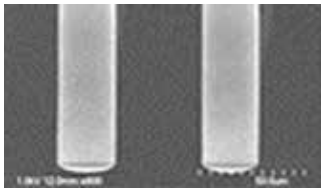


高アスペクト比エッチング



円柱形状構造

高速エッチング



TSVエッチング

Specifications

Process Module	Predeus	Proxion
ウェーハサイズ (mm)	200	200
プラットフォーム	APX, DPX, VPX, CPX	APX, DPX, VPX, CPX
エッチングスピード	Moderate	High
基板	Si	Si
アプリケーション	MEMS Gyroscope, MEMS Accelerometer	MEMS Microphone, Inkjet Printhead Manufacturing

Platform	APX	DPX	VPX	CPX
用途	R&D	Prototype	Small Volume	Mass Production
チャンバー数	1	2	3	4
搬送ロボット	-	Atmospheric	Vacuum	Vacuum
ロボット・モーション	2-Axis	2-Axis	3-Axis	3-Axis
カセット数	0	2	1	2

SPP Technologies Co., Ltd. | SPT Microtechnologies USA, Inc.
Japan | USA | Germany | Taiwan
www.sptcorp.com

©2025 SPT. All rights reserved.